

DS34LV87T

DS34LV87T Enhanced CMOS Quad Differential Line Driver



Literature Number: JAJ870

ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。



2000 年 11 月

DS34LV87T

3.3V CMOS4 回路入り差動出力ライン・ドライバ

概要

DS34LV87T は CMOS プロセスで作られた平衡伝送ラインでのデジタル・データ伝送用に設計された動作電源電圧 3.3V の 4 回路入り差動出力のライン・ドライバです。DS34LV87T は EIA-422B 及び CCITT V.11 に適合しており、同規格である DS34LV86T と組み合わせることにより 3.3V 電源における低消費、高速の 1 対 n のデジタル伝送が構成できます。電源電流、 I_{CC} が 100 μ A (Max) と少ないため、バッテリー動作や省電力を必要とするアプリケーションに最適です。また電源電圧が 3.3V 動作にもかかわらず差動出力電圧 (V_{OD})、2V を保証しています。

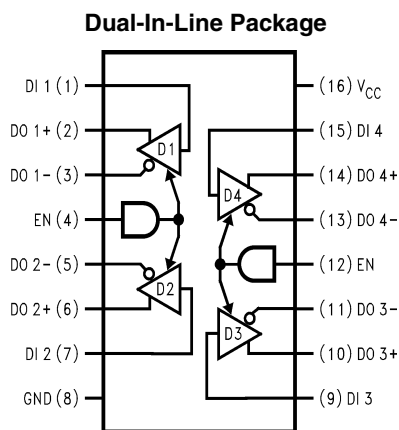
入力を TTL レベルで受け取り、出力を EIA-422 出力レベルに変換します。非能動時は出力を TRI-STATE にしておくことができますのでバスに対して負荷となりません。この設定は ENABLE 端子で行い、2 回路ずつ各々制御ができます。

5V 動作の DS34C87T とピン・コンパチブルです。

特長

- 3.3V 単一電源
- 低消費電流設計： $I_{CC} \leq 100 \mu A$
- EIA/TIA-422B(RS-422) 及び ITU-V.11 に適合
- 差動出力電圧： $V_{OD} \geq 2V$ を保証
- AC 特性を保証
ドライバスキュー： 2ns (最大値)
立ち上がり / 立ち下がり時間： 10ns (最大値)
- 伝搬遅延時間： 16ns (最大値)
- TRI-STATE 出力
- 電源断時、バスに対して負荷とならない
- 静電耐圧 (出力ピン)： $HBM \geq 7kV$
- 動作周囲温度： $-40 \sim 85^{\circ}C$
- DS34C87T とピンコンパチブル

ピン配置図



Top View
Order Number DS34LV87TM
See NS Package Number M16A

Truth Table

Enables	Input	Outputs	
EN	DI	DO +	DO -
L	X	Z	Z
H	H	H	L
H	L	L	H

L = Low logic state

X = Irrelevant

H = High logic state

Z = TRI-STATE

TRI-STATE[®] はナショナル セミコンダクター社の登録商標です。

絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電氣的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

最大電源電圧 (V_{CC})	$-0.5V \sim +7V$
最大入力インーブル電圧 (EN , EN^*)	$-0.5V \sim V_{CC} + 0.5V$
最大入力電圧 (V_{IN})	$-0.5V \sim V_{CC} + 0.5V$
最大出力耐圧 (V_{OUT})	$-0.5V \sim +7V$
最大クランプ・ダイオード電流 (I_{IK} , I_{OK})	$\pm 20\text{ mA}$
最大出力電流 (ピンあたり) (I_{OUT})	$\pm 150\text{ mA}$
最大パッケージ許容損失 (PD)(周囲温度 25°C において) (Note3)	
SOIC “ M ” パッケージ	1226mW
“ M ” パッケージ・デイレーティング (周囲温度 25°C 以上)	$9.8\text{ mW}/^\circ\text{C}$
保存温度範囲 (TSTG)	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$

許容リード温度 (ハンダ付け、4 秒)

 $+260^\circ\text{C}$

静電耐圧 (ESD)

(HBM、1.5k Ω 、100pF)

出力ピン

 $\geq 7\text{ kV}$

その他のピン

 $\geq 2.5\text{ kV}$ **推奨動作条件**

	最小値	代表値	最大値	単位
電源電圧 (V_{CC})	3.0	3.3	3.6	V
入力電圧 (V_{IN})	0		V_{CC}	V
出力耐圧 (V_{OUT})	0		V_{CC}	V
動作周囲温度	-40	$+25$	$+85$	$^\circ\text{C}$
入力立ち上がり、立ち下がり時間 (t_r , t_f)			500	ns

DC 電氣的特性特記のない限り、 $V_{CC} = 3.3V \pm 10\%$ (Note 2、3)

Symbol	Parameter	Conditions	Pin	Min	Typ	Max	Units
V_{OD1}	Output Differential Voltage	$R_L = \infty$, (No Load)	DO +,		3.3	4.0	V
V_{OD2}	Output Differential Voltage	$R_L = 100\Omega$ Figure 1	DO -	2	2.6		V
ΔV_{OD2}	Change in Magnitude of Output Differential Voltage			-400	7	400	mV
V_{OD3}	Output Differential Voltage	$R_L = 3900\Omega$ (V.11), Figure 1 (Note 7)			3.2	3.5	V
V_{OC}	Common Mode Voltage	$R_L = 100\Omega$ Figure 1			1.5	2	V
ΔV_{OC}	Change in Magnitude of Common Mode Voltage			-400	6	400	mV
I_{OZ}	TRI-STATE Leakage Current	$V_{OUT} = V_{CC}$ or GND Drivers Disabled			± 0.5	± 20	μA
I_{SC}	Output Short Circuit Current	$V_{OUT} = 0V$ $V_{IN} = V_{CC}$ or GND (Note 4)		-40	-70	-150	mA
I_{OFF}	Output Leakage Current	$V_{CC} = 0V$, $V_{OUT} = 3V$	DI, EN		0.03	100	μA
		$V_{CC} = 0V$, $V_{OUT} = -0.25V$			-0.08	-100	μA
V_{IH}	High Level Input Voltage			2.0		V_{CC}	V
V_{IL}	Low Level Input Voltage			GND		0.8	V
I_{IH}	High Level Input Current	$V_{IN} = V_{CC}$				10	μA
I_{IL}	Low Level Input Current	$V_{IN} = \text{GND}$		-10			μA
V_{CL}	Input Clamp Voltage	$I_{IN} = -18\text{ mA}$				-1.5	V
I_{CC}	Power Supply Current	No Load, $V_{IN}(\text{all}) = V_{CC}$ or GND	V_{CC}			100	μA

AC 電気的特性

特記のない限り、 $V_{CC} = 3.3V \pm 10\%$ (Note 5、6)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
t_{PHLD}	Differential Propagation Delay High to Low	$R_L = 100\Omega$, $C_L = 50\text{ pF}$ (Figure 2, 3)	6	10.5	16	ns
t_{PLHD}	Differential Propagation Delay Low to High		6	11	16	ns
t_{SKD}	Differential Skew $ t_{PHLD} - t_{PLHD} $			0.5	2.0	ns
t_{SK1}	Skew, Pin to Pin (same device)			1.0	2.0	ns
t_{SK2}	Skew, Part to Part (Note 8)			3.0	5.0	ns
t_{TLH}	Differential Transition Time Low to High (20% to 80%)			4.2	10	ns
t_{THL}	Differential Transition Time High to Low (80% to 20%)	(Figure 4, 5)		4.7	10	ns
t_{PHZ}	Disable Time High to Z			12	20	ns
t_{PLZ}	Disable Time Low to Z			9	20	ns
t_{PZH}	Enable Time Z to High			22	32	ns
t_{PZL}	Enable pTime Z to Low			22	32	ns
f_{MAX}	Maximum Operating Frequency (Note 9)			32		MHz

Note 1: 「絶対最大定格」とはこの値を超えるとデバイスの安全を保障できない値です。デバイスをこの規格値で動作する事を意味しているわけではありません。「電気的特性」の表にデバイスの実際の動作条件が示されています。

Note 2: V_{OD1} 、 V_{OD2} 、 V_{OD3} 以外の電圧はすべてグラウンドを基準としています。デバイスのピンに流れ込む電流はすべて正、デバイスのピンから流れ出す電流は負と示されています。

Note 3: すべての代表値は、 $V_{CC} = +3.3V$ 、 $T_A = +25^\circ\text{C}$ の値です。

Note 4: 高出力をグラウンドに短絡するときのソース電流です。短絡測定は 1 度に付き 1 回路です。

Note 5: $f = 1\text{ MHz}$ 、入力パルス条件 $t_r \leq 6\text{ ns}$ 、 $t_f \leq 6\text{ ns}$

Note 6: 詳細な試験条件に関しては、EIA 規格 EIA-422 を参照下さい。入力による測定値。その他はすべて V_{CC} と GRD における入力です。

Note 7: リミット値は TIA/EIA-422 及び ITU-TV.11 の規定に基づくものです。

Note 8: デバイス同士は同電源電圧で動作温度差が 5°C 以内とします。

Note 9: すべてのチャンネルの出力は入力 50% に対してデューティ比、40%、60% の値です。この値はデザイン上の保証値です。

Parameter Measurement Information

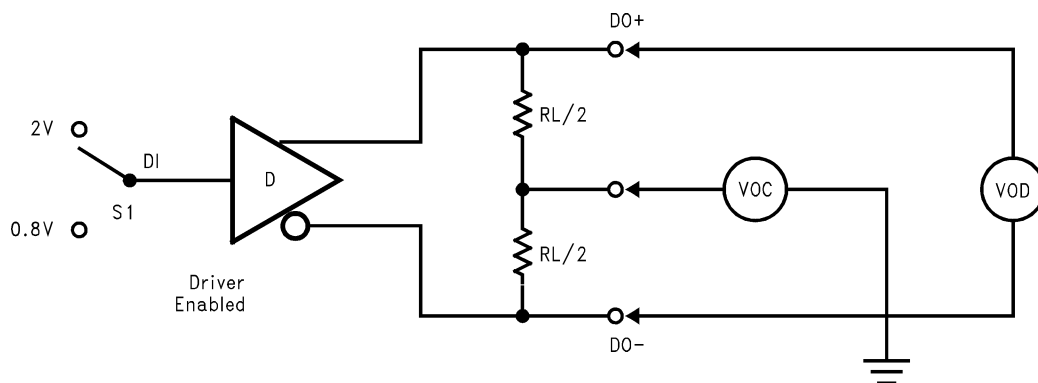


FIGURE 1. Differential Driver DC Test Circuit

Parameter Measurement Information (つづき)

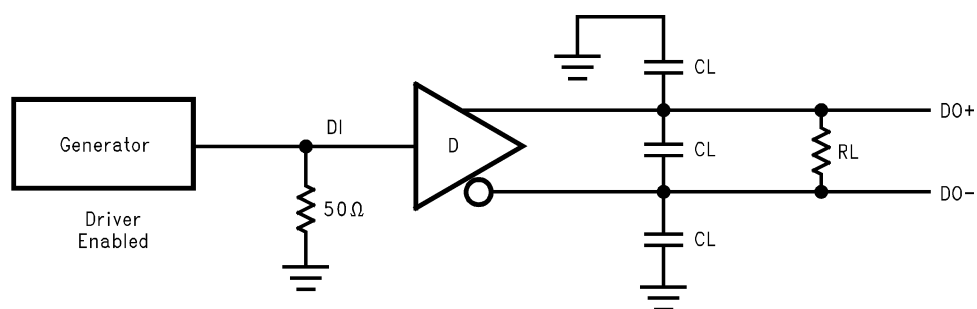


FIGURE 2. Differential Driver Propagation Delay and Transition Time Test Circuit

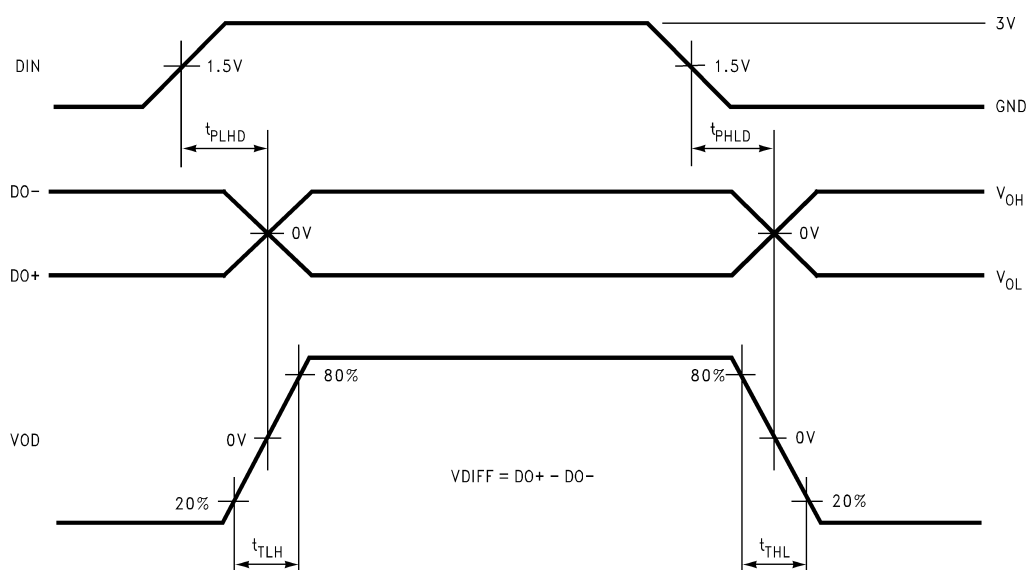


FIGURE 3. Differential Driver Propagation Delay and Transition Time Waveforms

Note 10: 特記のない限りパルスゼネレータの波形は $f = 1\text{MHz}$ 、 $t_r \leq 6\text{ns}$ 、 $t_f \leq 6\text{ns}$ 、 $Z_O = 50\Omega$ 、デューティ比 = 50%です。

Note 11: C_L はプローブと治具の容量を含みます。

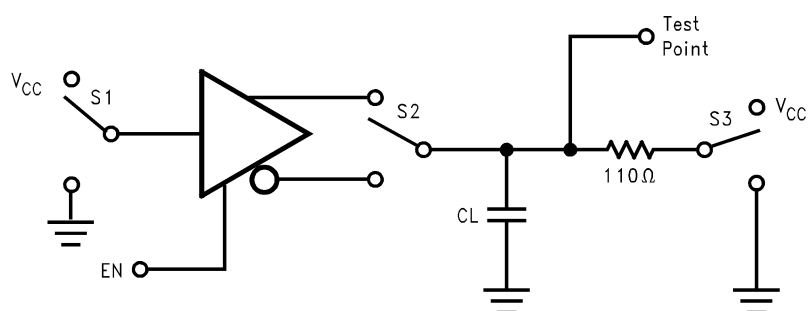


FIGURE 4. Driver Single-Ended TRI-STATE Test Circuit

Parameter Measurement Information (つづき)

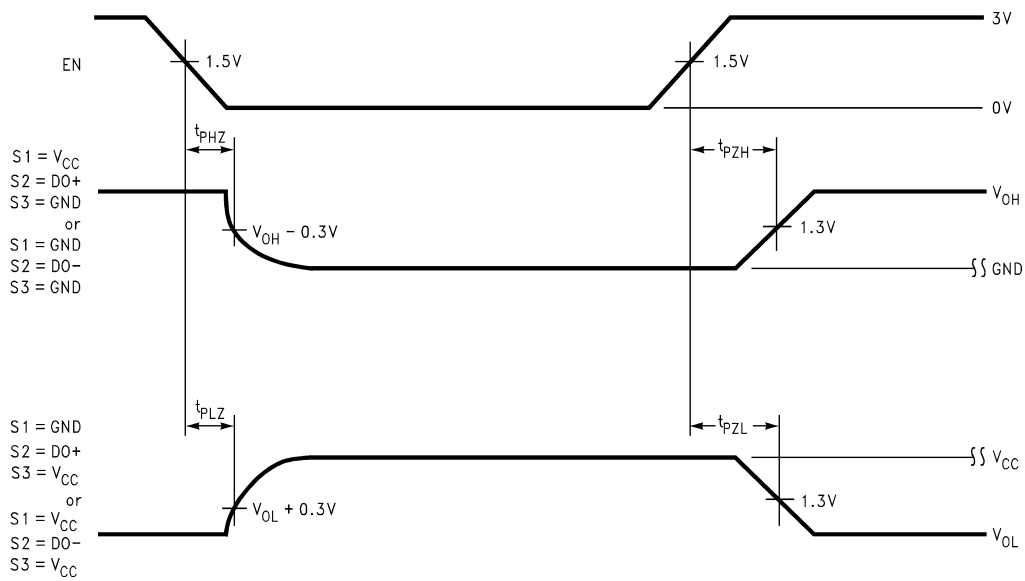


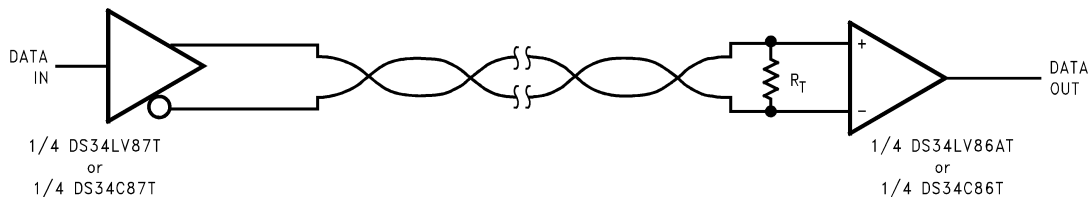
FIGURE 5. Driver Single-Ended TRI-STATE Waveforms

アプリケーション情報

電源のデカップリングコンデンサの推奨

高周波用のセラミックコンデンサ 0.01 μ F と 0.1 μ F のバイパスコンデンサ (表面実装用を推奨) を V_{CC} と GND ピン間に並列に接

続します。また PCB の電源入力部に 10 μ F 以上のタンタル又はケミカルコンデンサも接続するようにします。



R_T はオプションで、反射波を減らすために装着することをすすめます。

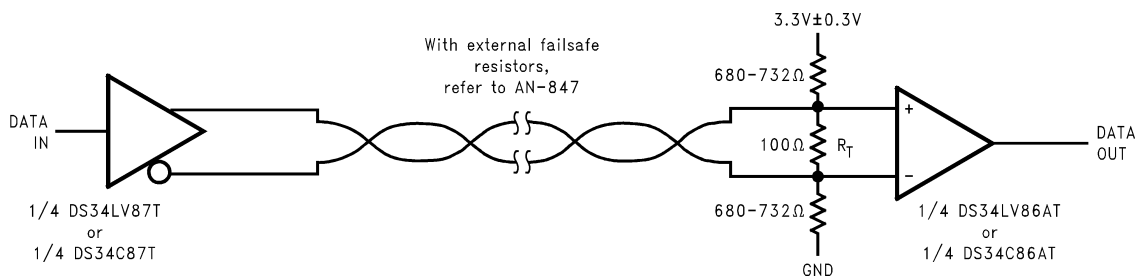


FIGURE 6 Typical Driver Connection

アプリケーション情報 (つづき)

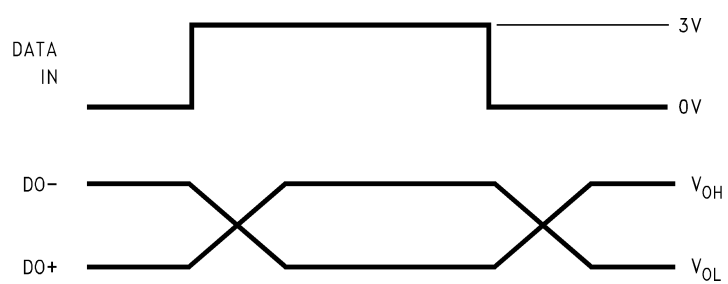
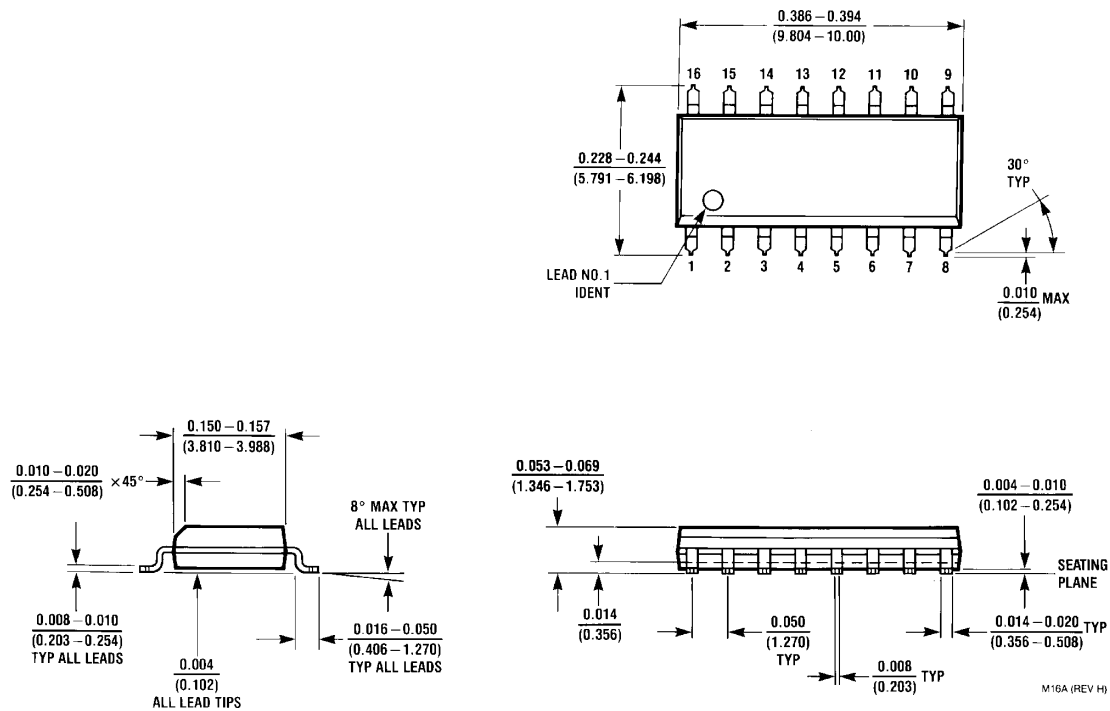


FIGURE 7. Typical Driver Output Waveforms

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)



16-Lead Molded Small Outline Package (M)
Order Number DS34LV87TM
NS Package Number M16A

生命維持装置への使用について

弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用することはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。
2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 / 英語）はホームページより入手可能です。

<http://www.national.com/JPN/>

その他のお問い合わせはフリーダイヤルをご利用下さい。

フリーダイヤル 0120-666-116

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取り引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光が当たる状態で保管・輸送しないこと。

3. 防湿梱包

- 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

4. 機械的衝撃

- 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

5. 熱衝撃

- はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）

6. 汚染

- はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
- はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上